Catálogo de productos

Amplificadores de potencia GaN

Los amplificadores de potencia GaN utilizan dispositivos de nitruro de galio en la etapa RF. Polarización, trayectoria térmica, forma de onda y carga determinan la salida útil del amplificador completo.



Productos: 18

Revisión: 15 · Fecha de revisión: 2026-11-12



LCPAM-2000-6000-100-485

Módulo amplificador de potencia RF GaN de banda ancha, 2–6 GHz, 100 W

El LCPAM-2000-6000-100-485 es un módulo amplificador RF de alta potencia y banda ancha con tecnología GaN para 2–6 GHz. Ofrece 100 W de salida saturada típica y 50 dB de ganancia típica. Funciona con 24–32 VDC e incorpora interfaz RS-485, supervisión de estado y desconexión de protección. Puede evaluarse como etapa de potencia en sistemas RF de 50 Ω.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

Potencia RF de salida saturada: Símbolo: Pout; Típico: 100; Unidad: W

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidad: dB

Tensión de operación: Símbolo: VDC; Mínimo: 24; Típico: 28; Máximo: 32; Unidad: VDC

Salvo indicación contraria: +28,0 VDC, 25 °C, sistema de 50 Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-100-18000-5

Amplificador de potencia GaN RF de 100–18000 MHz, mínimo 5 W

El amplificador GaN cubre 100–18000 MHz con salida saturada mínima de 5 W y típica de 7 W. La ganancia es mínima 37 dB y típica 38 dB, con planitud típica ±0.5 dB.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 100; Máximo: 18000; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 5; Típico: 7; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 37; Típico: 38; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-10700-12700-100

Amplificador de potencia GaN RF de 10700–12700 MHz, típico 100 W

El amplificador GaN cubre 10700–12700 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia típica de 50 dB. La planitud típica es ±1 dB, con armónicos típicos −50 dBc a 100 W de salida.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. Confirme con LCRF la corriente de funcionamiento y la actuación de la protección contra sobrecorriente antes de dimensionar la fuente de alimentación.

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-10700-12700-50

Amplificador de potencia GaN RF de 10700–12700 MHz, típico 50 W

El amplificador GaN entrega salida saturada típica de 50 W en 10700–12700 MHz y ganancia típica de 47 dB. La corriente dinámica típica es 10 A a 50 W, con corriente de reposo típica de 1.6 A.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12700; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 50; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 47; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-10700-12750-100

Amplificador GaN RF de 10700–12750 MHz, típico 100 W, adaptador WR75

El amplificador GaN cubre 10700–12750 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia mínima de 50 dB. La salida típica en compresión de 1 dB es 40 W; la corriente típica es 21 A a 100 W.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 10700; Máximo: 12750; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidad: W

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-2000-6000-20

Amplificador GaN RF de 2000–6000 MHz, salida saturada típica 25 W

La ficha de este modelo especifica salida saturada típica de 25 W en 2000–6000 MHz y ganancia típica de 44 dB. La corriente típica de 2.5 A y la eficiencia añadida de potencia de 30% se especifican ambas a 20 W de salida.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 25; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 44; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-3000-8000-100-485

Amplificador de potencia GaN RF de 3000–8000 MHz, típico 100 W, RS-485

El amplificador GaN cubre 3000–8000 MHz con salida saturada mínima de 80 W y típica de 100 W. La ganancia es mínima 49 dB y típica 50 dB; la corriente típica es 18 A a 100 W de salida.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 3000; Máximo: 8000; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 80; Típico: 100; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 49; Típico: 50; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-30-1000-10

Amplificador de potencia GaN RF de 30–1000 MHz, típico 10 W

El amplificador GaN cubre 30–1000 MHz con salida saturada mínima de 9 W y típica de 10 W. La ganancia típica es 40 dB con planitud ±1 dB; la corriente típica es 0.6 A a 10 W de salida.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1000; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 9; Típico: 10; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 40; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-30-1500-1

Amplificador de potencia GaN RF de 30–1500 MHz, mínimo 1 W

El módulo especifica salida saturada mínima de 1 W y ganancia mínima de 30 dB en 30–1500 MHz. La corriente típica es 0.15 A a 1 W, con planitud típica de ganancia ±1 dB.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 1500; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-30-2000-1

Amplificador de potencia GaN RF de 30–2000 MHz, mínimo 1 W

Este modelo cubre 30–2000 MHz según la tabla eléctrica, con salida saturada mínima de 1 W y ganancia mínima de 30 dB. Los armónicos típicos son −12 dBc a 1 W y las señales espurias típicas −60 dBc en saturación.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 30; Máximo: 2000; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 1; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 30; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-5000-6000-100

Módulo amplificador de potencia RF GaN de 5–6 GHz y ≥100 W

LCPAM-5000-6000-100 especifica una salida saturada mínima de 100 W y una ganancia mínima de 50 dB en PSAT entre 5 y 6 GHz, a 28 VDC, 25 °C y 50 Ω.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

Potencia RF de salida saturada: Símbolo: PSAT; Mínimo: 100; Unidad: W; PSAT

Ganancia de potencia (PSAT): Símbolo: Gp; Mínimo: 50; Unidad: dB; PSAT

Planitud de ganancia de potencia (PSAT): Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB; PSAT

28 VDC; 25 °C; 50 Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-5000-8500-25

Amplificador de potencia GaN RF de 5000–8500 MHz, típico 25 W

El amplificador GaN cubre 5000–8500 MHz con salida saturada mínima de 20 W y típica de 25 W. La ganancia es mínima 43 dB y típica 44 dB; los armónicos típicos son −40 dBc a 20 W.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 5000; Máximo: 8500; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-500-2500-100A

Amplificador de potencia GaN RF de 500–2500 MHz, típico 100 W, variante A

La variante A GaN cubre 500–2500 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia típica de 50 dB. La corriente típica es 12 A a 100 W, mientras la medición de armónicos mantiene su condición de salida a 70 W.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 500; Máximo: 2500; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Típico: 50; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω La tabla eléctrica indica 26 VDC mínimo, 28 VDC típico y 30 VDC máximo, mientras que la fila A1 VDD indica 28–32 VDC. Se omite la afirmación sobre el rango de A1. Confirmar el rango permitido y el cableado de A1 antes de alimentar; 32 VDC no es aquí un máximo operativo aceptado.

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-6000-8500-20

Amplificador de potencia GaN RF de 6000–8500 MHz, mínimo 20 W

La ficha de este modelo especifica salida saturada mínima de 20 W y típica de 25 W en 6000–8500 MHz. La corriente típica de 2.5 A y eficiencia añadida de potencia de 30% corresponden a 20 W; la corriente de reposo típica es 1.8 A.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidad: MHz

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-6000-8500-25

Amplificador de potencia GaN RF de 6000–8500 MHz, típico 25 W

Este modelo especifica salida saturada típica de 25 W y mínima de 20 W en 6000–8500 MHz. La ganancia es típica 44 dB y mínima 43 dB, con planitud típica ±0.5 dB.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 6000; Máximo: 8500; Unidad: MHz

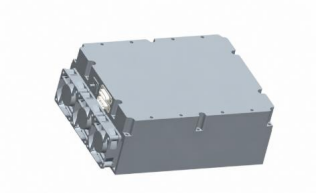
Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Mínimo: 20; Típico: 25; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 43; Típico: 44; Unidad: dB

Planitud de ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAM-8000-12000-100

Amplificador de potencia GaN RF de 8000–12000 MHz, típico 100 W

El amplificador GaN cubre 8000–12000 MHz con salida saturada típica de 100 W y ganancia mínima de 53 dB. La salida típica en compresión de 1 dB es 20 W, con planitud típica ±1.5 dB.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 20; Unidad: W

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 100; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAS-8000-12000-200

Sistema amplificador GaN RF de 8000–12000 MHz, típico 200 W

El sistema GaN cubre 8000–12000 MHz con salida saturada típica de 200 W y salida típica de 40 W en compresión de 1 dB. La ganancia es mínima 53 dB con planitud típica ±1.5 dB.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 40; Unidad: W

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 200; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 53; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPAS-8000-12000-400

Sistema amplificador GaN RF de 8000–12000 MHz, típico 400 W

El sistema GaN especifica salida saturada típica de 400 W en 8000–12000 MHz y salida típica de 120 W en compresión de 1 dB. La ganancia es mínima 56 dB con planitud típica ±1.5 dB.

Frecuencia de operación: Símbolo: BW; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P-1dB; Típico: 120; Unidad: W

Potencia de salida RF @ PSAT: Símbolo: PSAT; Típico: 400; Unidad: W

Ganancia de potencia @ PSAT: Símbolo: Gp; Mínimo: 56; Unidad: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.